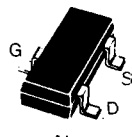


# n channel field effect transistors

transistors à effet de champ canal n

Types	V <sub>(BR) GSS</sub>		I <sub>GSS</sub> max (nA)	I <sub>DSS</sub>		V <sub>GS off</sub>		r <sub>DS on</sub> max (Ω)	t <sub>off</sub> max (ns)	C <sub>11SS</sub> max (pF)	C <sub>12SS</sub> max (pF)	Y <sub>21S</sub>		F <sub>B</sub> @ f		Marking*	Pin out
	min (V)	max (V)		min	max	min	max					min	max	max	(MHz)		
SO 4416	30	0,1	5	15	-	6				4	0,9	4,5	7,5	4	400	FOI	
BFR 30 (R)	25	0,2	4	10	-	5				4	1,5	1	4	(1)	MI (F13)		
BFR 31 (R)	25	0,2	1	5	-	2,5				4	1,5	1,5	4,5	(1)	M2 (F14)		
SO 245 A (R)	30	5	2	6,5	-0,5	- 8				4§	1,1§	3	6,5		F 21 (F24)		
SO 245 B (R)	30	5	6	15	-0,5	- 8				4§	1,1§	3	6,5		F 12 (F20)		
SO 245 C (R)	30	5	12	25	-0,5	- 8				4§	1,1§	3	6,5		F 25 (F26)		
SO 3966	30	0,1	2		-4	- 6	220	100		9	1,5				F09 (F29)		
BSR 56	40	1	50		-4	-10	25	25			5				M4		
BSR 57	40	1	20	100	-2	- 6	40	50			5				M5		
BSR 58	40	1	8	80	-0,8	- 4	60	100			5				M6		
SO 4091 (R)	40	0,2	30		-5	-10	30	40	28	5					F02 (F22)		
SO 4092 (R)	40	0,2	15		-2	- 7	50	60	28	5					F10 (F30)		
SO 4093 (R)	40	0,2	8		-1	- 5	80	80	28	5					F11 (F31)		
SO 4391 (R)	40	0,1	50	150	-4	-10	30	35	26	4					F03 (F23)		
SO 4392 (R)	40	0,1	25	75	-2	- 5	60	55	26	4					F07 (F27)		
SO 4393 (R)	40	0,1	5	30	-0,5	- 3	100	80	26	4					F08 (F28)		
SO 5432 (R)	25	0,2	150		-4	-10	5	36	30	15					F15 (F16)		
SO 5433 (R)	25	0,2	100		-3	- 9	7	36	30	15					F17 (F18)		
SO 5434 (R)	25	0,2	30		-1	- 4	10	36	30	15					F19 (F32)		

(1) V<sub>n</sub> (I<sub>D</sub> = 200μA V<sub>DS</sub> = 10V f = 0,6...100 Hz) : max 0,5 μV

\* Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R  
Marquage entre parenthèses : se référer au brochage R

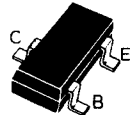
§ : Typical value  
Valeur typique

# Datasheet Directory

## general purpose darlington

darlington usage général

NNNN

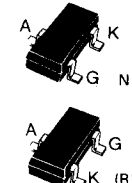
Types		Maximum ratings		Characteristics at 25°C										Marking	Pin out
NPN	PNP	P <sub>(tot)</sub>	V <sub>CEO</sub>	h <sub>21E</sub> @ I <sub>C</sub>	V <sub>CE(sat)</sub> @ I <sub>C</sub> /I <sub>B</sub>	f <sub>T</sub>	C <sub>22b</sub>	F <sub>B</sub> 1 kHz	t <sub>off</sub>						
		(mW)	(V)	min max	max	min	max	max	max	max					
SO 517		350	30	30K	100	1	100/1	220§	3,5§				N94		
BCV 27		350	30	20K	100	1	100/1	200§	3,5§				FD		
	BCV 26	350	30	20K	100	1	100/1	200§	3,5§				FF		
	BCV 47	350	60	10K	100	1	100/1	200§	3,5§				FE		
	BCV 46	350	60	10K	100	1	100/1	200§	3,5§				FG		
		350	60	10K	100	1	100/1	200§	3,5§						

§ : Typical value - Valeur typique

N : New product - Nouveau produit

## thyristors

thyristors

Types	Maximum ratings					Characteristics at 25°C					Marking*	Pin out	
	V <sub>DRM</sub>	V <sub>RRM</sub>	I <sub>T rms</sub>	I <sub>T SM</sub>	T <sub>oper</sub>	I <sub>GT</sub>	di/dt	dv/dt	t <sub>q</sub>				
	(V)	(V)	(A)	t <sub>p</sub> = 10 ms T <sub>c</sub> = 25°C	(°C)	T <sub>c</sub> = 25°C max	max	typ	typ				
SO BRY 55.30(R)	30	30	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8			D 52 (D65)	
SO BRY 55.60(R)	60	60	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8			D 66 (D67)	
SO BRY 55.100(R)	100	100	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8			D 78 (D79)	
SO BRY 55.200(R)	200	200	0,45	4	-40 + 125	0,2	100	10	8			D 87 (D82)	

\* Marking into brackets, refer to reverse pin configuration R.  
Marquage entre parenthèses, se référer au brochage R.